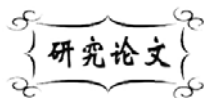


中图分类号: O73
文献标识码: A

文献编号: 1005-1198 (2017) 01-0057-07
DOI: 10.16253/j.cnki.37-1226/tq.2016.09.006



二维碳化物与石墨烯相互作用的第一性原理研究

陈进峰, 胡前库, 周爱国

河南理工大学 材料科学与工程学院, 河南 焦作 454000

摘要: 二维 $\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$ -石墨烯复合材料导电性能好、比容量高, 在储能领域有很重要的应用前景。研究 Ti_2C 、 Ti_3C_2 表面与石墨烯的相互作用, 有助于认识碳元素对二维碳化物表面修饰的特性。通过计算对比 Ti_2C 、 Ti_3C_2 与 TiC (111) 的表面原子、电子结构, 确定 Ti_2C 、 Ti_3C_2 与 TiC (111) 具有相似的活性。从 Ti_2C 、 Ti_3C_2 与石墨烯复合得到的材料电子结构可以看出, 吸附后石墨烯层内电子结构发生了明显的变化, 两类二维结构间存在有强于范德华力的结合。

关键词: 二维碳化物; 石墨烯; 第一性原理

二维材料因其特殊的维度效应^[1,2]、高比表面积^[3]而具有特殊的物理化学性能。在石墨烯应用与研究的推动下, 越来越多的二维材料逐渐成为研究热点。石墨烯^[3,4]、六方氮化硼^[1]、 MoS_2 和 WSe_2 ^[2] 等具有各种各样的电学性能。二维钛碳化物 $\text{Ti}_{n+1}\text{C}_n$ ($n = 1, 2, 3$) 由 $\text{Ti}_{n+1}\text{AC}_n$ ($A = \text{Al}, \text{Si}$) 相在氢氟酸溶液^[5,6]或氟盐与酸的混合溶液^[7]中选择性地被刻蚀掉其中的 A 原子层制备而来。 $\text{Ti}_{n+1}\text{AC}_n$ 属于典型的 MAX 相^[8]。MAX 作为一类特殊的三元层状化合物, 化学式为 $\text{M}_{n+1}\text{AX}_n$, 其中 M 为早期过渡金属, A 表示 III、IV 主族元素, X 表示 C 或 N。 $\text{Ti}_{n+1}\text{C}_n$ 具有与石墨烯类似的二维结构, 因此也被称为 MXene^[9]。其结构中, Ti、C 原子层沿垂直于二维表面的方向交替堆叠, 最外层为 Ti 原子, C 原子位于 Ti 原子形成的八面体空隙中。在储能领域 (包括储氢^[10]、锂离子电池^[11,12]、超级电容器^[7,13]、燃料电池^[14]等) 对 MXene 开展的广泛研究证明了此类材料有很好的应用前景。

MXene 与石墨烯形成的复合材料具有高导电性^[15]、高比容量^[16], 这类材料在薄膜电极领域方面具有很好的应用前景。然而, 石墨烯与 MXene 表面间的相互作用并没有得到明确的报道, 碳原子对 MXene 表面的修饰作用也未见研究。 Ti_2C 、 Ti_3C_2 表面与 TiC (111) 面具有相似的表面结构^[17]。实验

收稿日期: 2016-09-29

收到修改稿日期: 2016-10-08

基金项目: 国家自然科学基金 (51202058; 51205111; 51472075); 河南理工大学创新型科研团队 (T2013-4); 河南理工大学杰出青年基金 (J2015-3)。

第一作者: 陈进峰 (1989-), 男, 河南郑州人, 硕士研究生。E-mail: jinmount@gmail.com。

通讯作者: 胡前库 (1977-), 男, 河北石家庄人, 副教授。E-mail: hqk@hpu.edu.cn。

研究发现, TiC (111) 面上可以生长单层石墨烯; 而且, 在 1600°C 以上单层石墨烯会蒸发, 重新获得干净的 TiC (111) 面^[18]。

本文将借助于第一性原理的方法研究单层石墨烯与 Ti₂C、Ti₃C₂ 表面间的相互作用。

1 计算方法

本文采用密度泛函理论 (Density Functional Theory, DFT) 实现第一性原理计算, 利用基于 VASP 软件包^[19]中的全电子缀加平面波方法 (Projector Augmented-Wave, PAW)^[20], 交换关联能则用 GGA-PBE 进行处理。平面波截断能取 600 eV 以确保总能收敛精度设为 1.0×10^{-3} eV·cell⁻¹。用 Monkhorst-Pack 方法产生 $11 \times 11 \times 2$ K-Point, 所有结构保持层间大于 1.5 nm 的真空层, 以阻止相邻层间的相互作用。

根据实验报道中石墨烯在 TiC (111) 面生长时碳原子的位置信息^[18], 构建初始结构模型进行结构优化。为了对比 MXene 表面与 TiC (111) 面的相似性, 本文对 TiC (111) 面也进行了结构优化, 沿 <111> 方向截取 7 层原子 (如图 1 所示), 使 Ti 原子层为上表面, 并固定最底端的两层原子。

石墨烯与 Ti₂C、Ti₃C₂ 的相互作用在能量上表征为吸附能 E_{ad} 。吸附能定义如下:

$$E_{ad} = (E_{MXene}^{graphene} - E_{MXene} - E_{graphene})/a \quad (1)$$

其中, $E_{MXene}^{graphene}$ 表示石墨烯吸附在 MXene (Ti₂C、Ti₃C₂) 表面的总自由能, E_{MXene} 表示纯净 MXene 的自由能, $E_{graphene}$ 表示单层石墨烯的自由能, a 为 MXene 表面石墨烯层中包含的 C 原子个数。

2 结果与讨论

2.1 Ti₂C、Ti₃C₂、TiC (111) 表面结构对比

如图 1 所示, Ti₂C、Ti₃C₂ 与 TiC (111) 面结构基本相同: C 原子位于 Ti 原子构成的八面体空隙, 表面 Ti 原子与相邻的三个碳原子形成稳定键合, 并在表面形成文献中所报道的三种高对称性位置 (最外层 Ti、C 原子正上方以及次外层 Ti 原子正上方)。

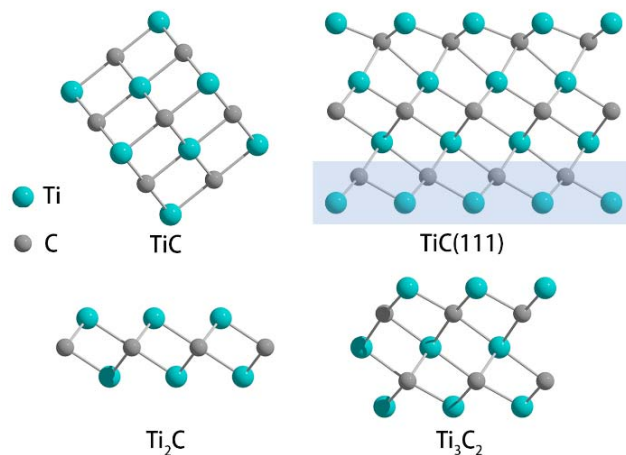


图 1 纯净 MXene、TiC (111) 面、TiC 晶体结构图
Figure 1 Structure of pristine MXene, TiC (111) surface and bulk TiC

表 1 Ti_2C 、 Ti_3C_2 、 TiC (111) 面以及 TiC 结构中的 Ti–C 键长
Table 1 Length of Ti–C bond in the structure of Ti_2C , Ti_3C_2 , TiC (111) surface and bulk TiC

Ti_2C		Ti_3C_2		TiC (111) surface		TiC	
Ti–C	2.098	Ti1–C	2.053	Ti1–C1	2.043	Ti–C	2.168
		Ti2–C	2.225	Ti2–C1	2.258		
键长/Å				Ti2–C2	2.129		
				Ti3–C2	2.167		
				Ti3–C3	2.174		

注：Ti、C 原子后的数字表示两种原子层从外到内在结构中的位置。根据对称性， Ti_2C 、 TiC 结构中只有一种 Ti 原子位置和一种 C 原子位置， Ti_3C_2 只有一种 C 原子位置和两种 Ti 原子位置。

表 1 列出了 Ti_2C 、 Ti_3C_2 、 TiC (111) 以及 TiC 块体结构中键长的对比结果，表面 Ti–C 键长最短，表面的 Ti–C 结合较内部更加紧密。 TiC (111) 面自第二层 C 原子以里结构依然保持 TiC 块体内部结构特征。

2.2 Ti_2C 、 Ti_3C_2 、 TiC (111) 表面电子结构对比

三种结构表面 Ti 原子的投影态密度如图 2 所示。可以看出，三种结构的表面活性都来源于 Ti 原子的 d 轨道电子，随着结构中原子层数的增加，Ti 原子的电子（特别是 d 轨道电子）倾向于分布在能级更低的轨道。 Ti_2C 表面 Ti 原子的电子最高能级约为 9 eV， Ti_3C_2 表面 Ti 原子的最高能级约为 6 eV， TiC (111) 表面 Ti 原子的最

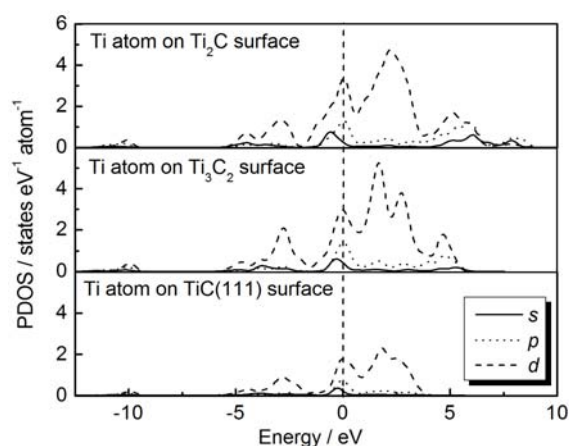


图 2 Ti_2C 、 Ti_3C_2 、 TiC (111) 表面 Ti 原子的投影态密度
Figure 2 Projected density of states (PDOS) of Ti atoms on Ti_2C , Ti_3C_2 , TiC (111) surfaces

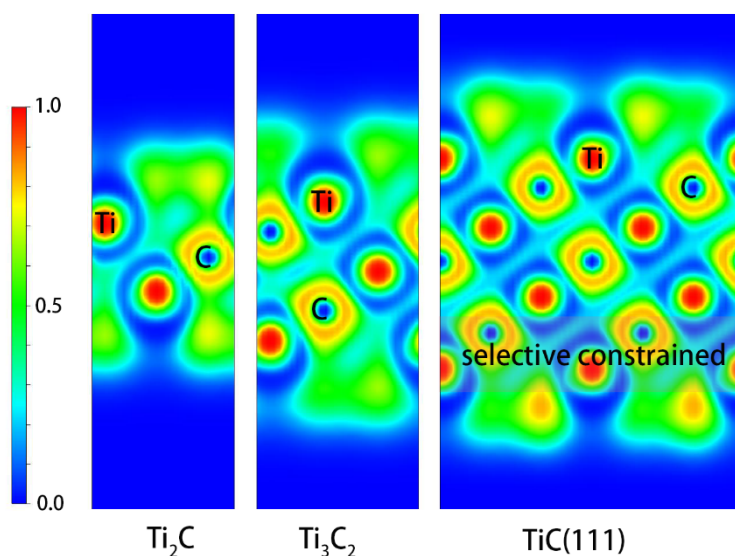


图 3 Ti_2C 、 Ti_3C_2 、 TiC (111) 表面 (110) 切面的 ELF 分析
Figure 3 ELF of (110) section for Ti_2C , Ti_3C_2 , TiC (111) surfaces

高能级则为 4 eV。这说明 Ti_2C 结构中的 Ti-C 键相对于最稳定的 TiC 块体结构中的 Ti-C 键畸变程度最大, 表面 Ti 原子的反应活性也最强。随着原子层数的增加, 三种结构表面的活性逐渐降低。

下一部分的讨论中将看到, 石墨烯在 Ti_3C_2 表面的吸附能略高于 Ti_2C 表面 (约 $0.06 \text{ eV}\cdot\text{atom}^{-1}$), 这也进一步印证了上述结论。

电子局域函数 (Electron Localization Function, ELF) 表征了电子的局域化分布特征。三种结构的 ELF 示于图 3。图中 TiC (111) 面最下方的原子被假设在 TiC 块体结构内部, 因此在计算过程中底部两层原子的位置被选择性地限制, 同时图中下表面的结果并没有太大意义。在 Ti_2C 、 Ti_3C_2 、TiC (111) 面绿色区域为电子局域化程度很低的位置, 呈自由电子状态, 这一位置其实也是实验中制备的 MXene 表面官能团 (O/OH, F) 最稳定的吸附位。

2.3 石墨烯吸附于 MXene 表面的吸附能及结构特征

根据文献报道中单层石墨烯生长在 TiC (111) 表面的结构特征^[18], 在 MXene 上下两个表面分别根据对称性放置单层 C 原子进行结构优化。图 4 和图 5 分别是结构优化后的 Ti_6C_{19} (Ti_2C -石墨烯)、 Ti_9C_{22} (Ti_3C_2 -石墨烯) 的 2×2 超胞结构模型, 结构中吸附于 MXene 表面的单层 C 原子排布依然保持蜂窝形状, 与文献报道 TiC (111) 表面生长的石墨烯单层结构一致。

优化后, 石墨烯层内最近邻 C 原子距离为 $1.46 \text{ \AA} \sim 1.48 \text{ \AA}$, 与单层石墨烯中 C-C 键长 1.42 \AA 相比增加了约 3.5%。石墨烯层中 C 原子与 MXene 表面 Ti 原子形成的最短键长约为 2.2 \AA 。

根据式 (1) 的定义, 石墨烯作用于 Ti_2C 、 Ti_3C_2 的吸附能分别是 $-0.193 \text{ eV}\cdot\text{atom}^{-1}$ 和 $-0.126 \text{ eV}\cdot\text{atom}^{-1}$ 。

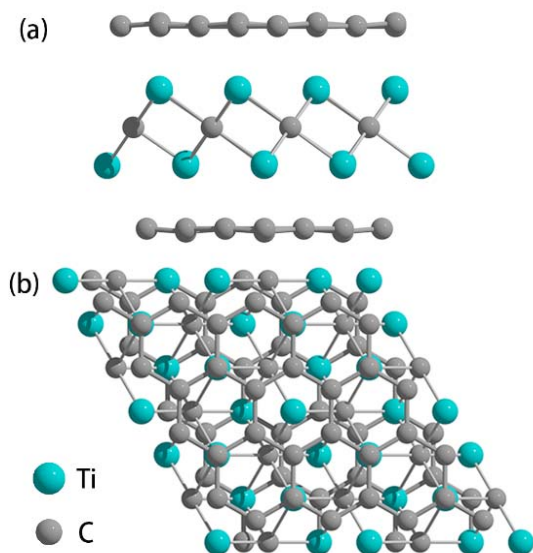


图 4 石墨烯吸附于 Ti_2C 表面的结构
Figure 4 Structure of Ti_2C -graphene:
(a) side view; (b) top view

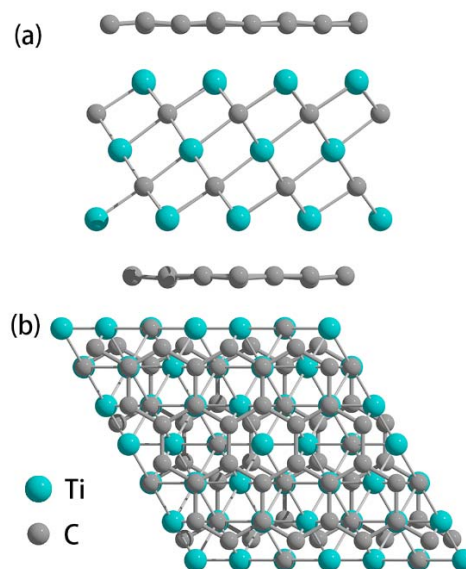


图 5 石墨烯吸附于 Ti_3C_2 表面的结构
Figure 5 Structure of Ti_3C_2 -graphene:
(a) side view; (b) top view

2.4 石墨烯吸附于 MXene 表面的电子结构

表 2 为石墨烯与纯净的 MXene 相互作用前后的 Bader 电荷分析结果。单层石墨烯中, C-C 成键, 呈蜂窝状分布; 部分碳原子得电子, 另一部分碳原子则失去相应数目的电子。与 MXene 二维结构相

互作用之后, 石墨烯中 C-C 键伸长的同时, 每个 C 原子的电子数都相应增多。MXene 结构中 C 原子得到的电子减少, Ti 原子失去的电子却增多, 也表明单层石墨烯与 MXene 表面有电子交换, 两者之间属于化学作用。

表 3 石墨烯与 MXene 相互作用前后 Bader 电荷分析
Table 3 Bader analysis of graphene, MXene and MXene-graphene.

Species	Bader charge / e				
	Graphene	Ti ₂ C	Ti ₂ C-graphene	Ti ₃ C ₂	Ti ₃ C ₂ -graphene
Ti1		1.07	1.38	1.17	1.42
C		-2.15	-1.85	-1.96	-1.77
C-graphene	+0.1/-0.1		-0.1 ~ -0.3		-0.07 ~ -0.31
Ti2				1.59	1.62

图 6 所示为石墨烯与 MXene 作用前后原子态密度的变化情况。吸附于 MXene 表面后, 石墨层中电子的局域化程度明显增加, 都分布于 5 eV 以下, 石墨烯层内的电子结构发生明显变化。通过对比可知, Ti 的 *s* 轨道与石墨烯层中 C 原子 *s*、*p* 电子轨道在 -20 eV 附近重叠, 而在高于 2.5 eV 能级只有石墨烯层中 C 原子的 *p* 轨道与 Ti 原子的电子轨道重叠。这说明石墨烯与 MXene 之间 Ti、C 原子形成了化学键, 二者之间的结合强于范德华力。

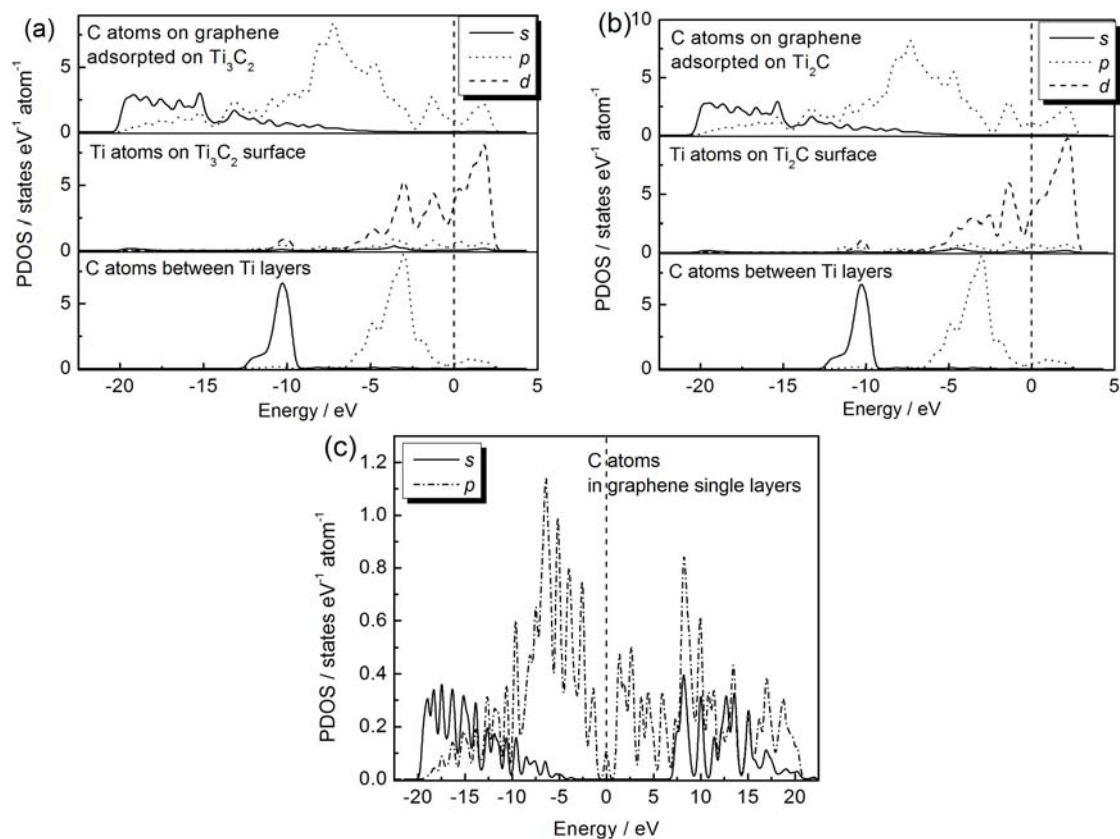


图 6 单层石墨烯已经 MXene-石墨烯中 Ti、C 原子的投影态密度:

(a) Ti₃C₂-石墨烯; (b) Ti₂C-石墨烯; (c) 石墨烯

Figure 6 Projected density of states (PDOS) of Ti atoms and C atoms in structure of graphene and MXene-graphene: (a) Ti₃C₂-graphene; (b) Ti₂C-graphene; (c) graphene

图 7 所示的 ELF 分析结果表明石墨烯与 MXene 表面相互作用后, 随着电子数目的增加, 电子的局域化分布也发生了明显的改变。吸附后电子主要局域于相邻两个 C 原子对之间, 而自由电子则分布于六元环的外层。

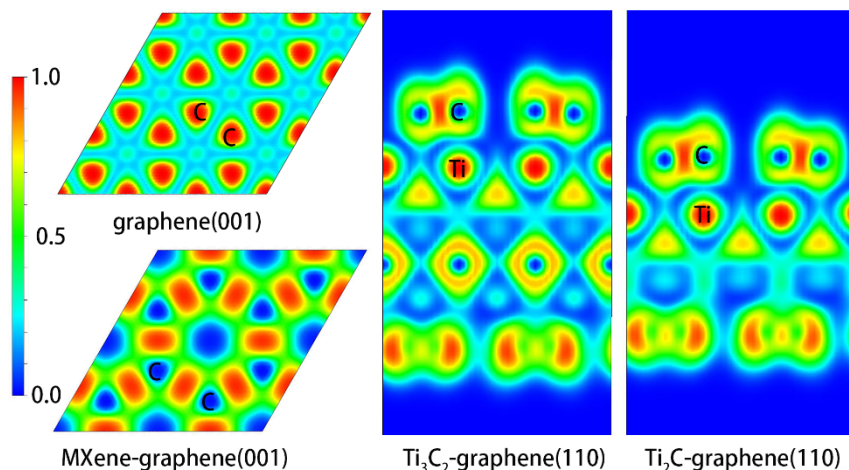


图 7 石墨烯、MXene-石墨烯 (001) 表面以及 MXene-石墨烯 (110) 面的 ELF 分析

Figure 7 ELFs of (001) section for graphene, MXene-graphene and (110) section for MXene-graphene

3 结 论

本文通过第一性原理计算, 对比了 Ti_2C 、 Ti_3C_2 和 TiC (111) 三种结构的表面特征。三种结构表面都因为 Ti 原子的 d 电子轨道而具有较高的表面活性, 表面活性随着结构中原子层数的增加而减弱。石墨烯吸附于 MXene 表面, 表面结构特征与文献报道的 TiC (111) 情况一致, 二者之间的结合力强于范德华力。两者相互作用后, 石墨烯中 C-C 键长增加约 3.5%。从 MXene 获得电子后, 石墨烯的电子结构发生明显改变, 层内电子主要局域于 C-C 原子间。

参考文献

- [1] CI L, SONG L, JIN C, et al. Atomic layers of hybridized boron nitride and graphene domains [J]. *Nature Materials*, 2010, 9 (5): 430–435.
- [2] VAN DER ZANDE AM, HUANG PY, CHENET DA, et al. Grains and grain boundaries in highly crystalline monolayer molybdenum disulphide [J]. *Nature Materials*, 2013, 12 (6): 554–561.
- [3] NOVOSELOV KS, GEIM AK, MOROZOV S, et al. Electric field effect in atomically thin carbon films [J]. *Science*, 2004, 306 (5696): 666–669.
- [4] AISSA B, MEMON NK, ALI A, et al. Recent progress in the growth and applications of graphene as a smart material: a review [J]. *Frontiers in Materials*, 2015, 2: No. 58.
- [5] NAGUIB M, KURTOGLU M, PRESSER V, et al. Two-dimensional nanocrystals produced by exfoliation of Ti_3AlC_2 [J]. *Advanced Materials*, 2011, 23 (37): 4248–4253.
- [6] NAGUIB M, MASHTALIR O, CARLE J, et al. Two-dimensional transition metal carbides [J]. *ACS Nano*, 2012, 6 (2): 1322–1331.
- [7] GHIDIU M, LUKATSKAYA MR, ZHAO MQ, et al. Conductive two-dimensional titanium carbide 'clay' with high volumetric capacitance [J]. *Nature*, 2014, 516 (7529): 78–81.
- [8] BARSOUM MW. The $M_{N+1}AX_N$ phases: a new class of solids [J]. *Progress in Solid State Chemistry*, 2000, 28 (1–4): 201–281.

